

止蝕刻，側壁即形成如圖 6-25 所示。

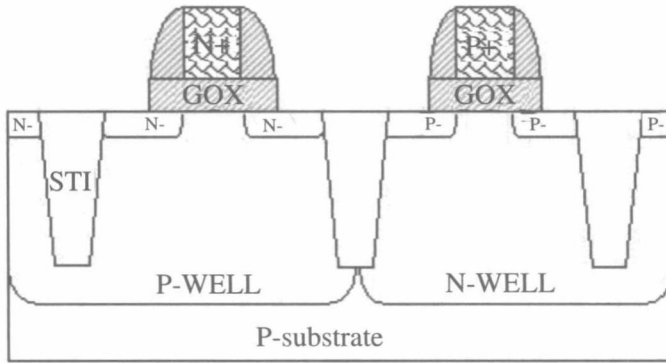


圖 6-25 Spacer 之形成。

## 7. 源／汲極（Source/Drain, S/D）製程

S/D 也屬於高濃度摻雜的一種，其深度較 LDD 略深，但不比之前 Well 植入那麼深，主要製程步驟分別是：

- (1) N 型源／汲極之微影及五價原子植入，最後再把光阻移除，即形成  $N^+$  S/D，如圖 6-26 所示。

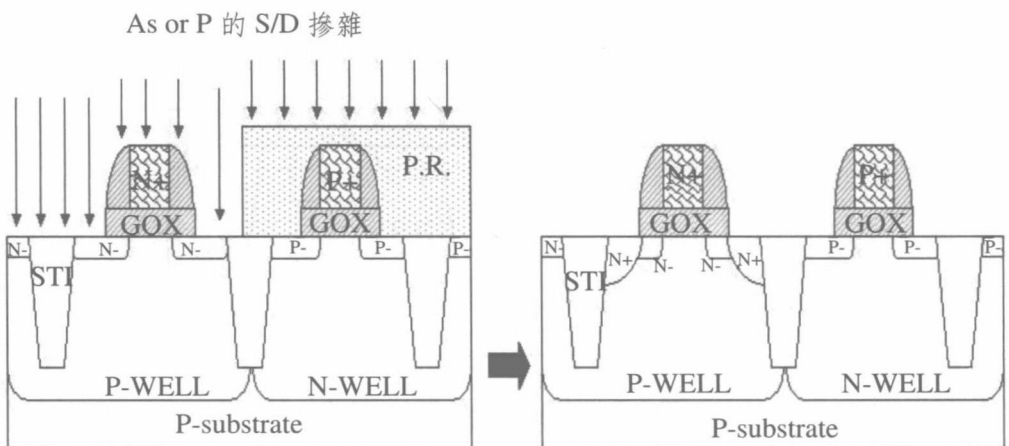


圖 6-26  $N^+$  S/D 之製作流程。